

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-36888

(43)公開日 平成8年(1996)2月6日

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

G 11 C 14/00

11/22

H 01 L 27/10

4 5 1

G 11 C 11/34

3 5 2 A

7735-4M

H 01 L 27/10

6 5 1

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全11頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平6-170844

(22)出願日

平成6年(1994)7月22日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 平野 博茂

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 角 辰巳

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 長野 能久

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

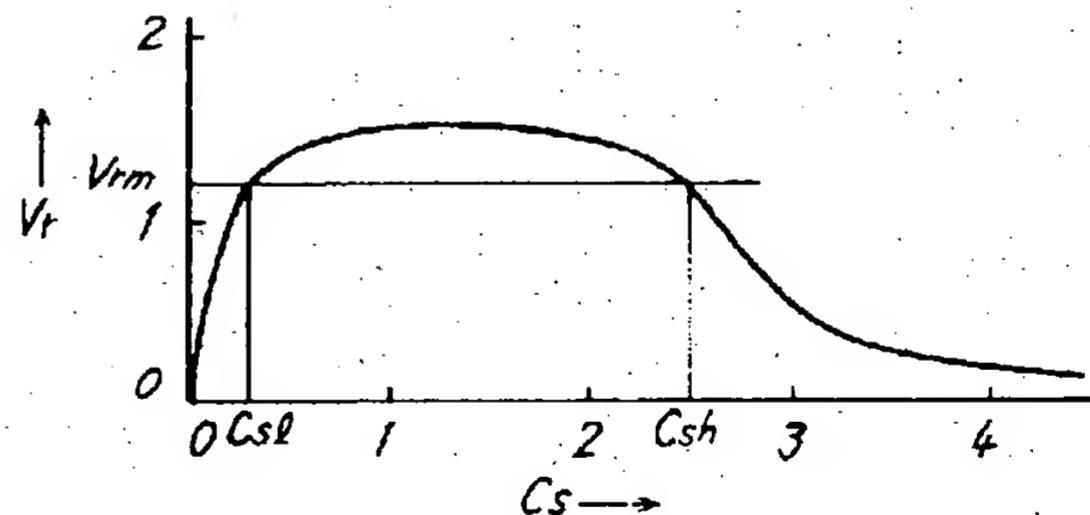
(74)代理人 弁理士 小鍛治 明 (外2名)

(54)【発明の名称】 半導体メモリ装置

(57)【要約】

【目的】 ビット線へのデータ読み出し電位を大きくする。

【構成】 本体メモリセルキャパシタ容量値C_sとビット線BL0, /BL0間に読み出された電位差V_rとの関係から、電位差V_rは本体メモリセルキャパシタ容量値C_sに対して最大値をもつ曲線で表される。V_rはセンサアンプで正確に増幅できる読み出し可能最低電位差値を示している。このV_rと図の曲線の交点のうち本体メモリセルキャパシタ容量値の小さい方をC_sl、本体メモリセルキャパシタ容量値の大きい方をC_shとする。本体メモリセルキャパシタ容量の値C_sはC_slとC_shとの間にあることが必要である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 増幅器に第1のビット線と前記第1のビット線と対になった第2のビット線が接続され、第1のMOSトランジスタに第1のワード線と第1の強誘電体キャパシタと前記第1のビット線とが接続され、前記第1の強誘電体キャパシタが第1のプレート電極に接続され、前記第1のビット線と前記第2のビット線との間に生じる電位差を所望の値にするように前記第1の強誘電体キャパシタの容量が決定されることを特徴とする半導体メモリ装置。

【請求項2】 前記電位差が前記増幅器によって正常に増幅できる値であることを特徴とする請求項1記載の半導体メモリ装置。

【請求項3】 前記容量が小さく設定されることを特徴とする請求項2記載の半導体メモリ装置。

【請求項4】 増幅器に第1のビット線と前記第1のビット線と対になった第2のビット線が接続され、第1のMOSトランジスタに第1のワード線と第1の強誘電体キャパシタと前記第1のビット線とが接続され、前記第1の強誘電体キャパシタが第1のプレート電極に接続され、第2のMOSトランジスタが第2のワード線と第1のキャパシタと前記第2のビット線とに接続され、前記第1のキャパシタが第2のプレート電極に接続され、前記第1の強誘電体キャパシタの論理電圧“H”で、かつ前記第1のビット線へのデータ読み出し時の第1のビット線電位と前記第1の強誘電体キャパシタの論理電圧“L”で、かつ前記第1のビット線へのデータ読み出し時の第2のビット線電位との電位差が第1の所望の値になるように前記第1の強誘電体キャパシタの容量が決定され、前記第1のキャパシタの前記第2のビット線へのデータ読み出し時の第3のビット線電位が前記第1のビット線電位と前記第2のビット線電位との中間の第2の所望の値の電位になるように前記第1のキャパシタの容量が決定されることを特徴とする半導体メモリ装置。

【請求項5】 前記第1のキャパシタが強誘電体キャパシタであることを特徴とする請求項4記載の半導体メモリ装置。

【請求項6】 前記第1のキャパシタが前記第1の強誘電体キャパシタと同程度の形状である強誘電体キャパシタであることを特徴とする請求項4記載の半導体メモリ装置。

【請求項7】 前記第1のキャパシタの前記第2のビット線へのデータ読み出し時に前記第2のビット線の容量に第1のビット線容量調整用容量が接続され前記第1のビット線の容量より大きくなることを特徴とする請求項4記載の半導体メモリ装置。

【請求項8】 前記第1のビット線容量調整用容量が強誘電体キャパシタであることを特徴とする請求項7記載の半導体メモリ装置。

【請求項9】 前記第1のキャパシタの前記第2のビッ

ト線へのデータ読み出し時に前記第2のビット線の容量に第1のビット線容量調整用容量が接続され前記第1のビット線の容量より小さくなることを特徴とする請求項4記載の半導体メモリ装置。

【請求項10】 前記第1のビット線容量調整用容量が強誘電体キャパシタであることを特徴とする請求項9記載の半導体メモリ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、半導体メモリ装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 半導体メモリ装置では、半導体装置内に形成されたキャパシタに電荷を蓄積し、その電荷の有無によりデータを記憶する方式が主に用いられており（一般にダイナミック方式メモリという。以下この方式のメモリをDRAMと称す）、そのキャパシタには、従来、シリコン酸化膜を絶縁膜として用いている。

【0003】 近年、強誘電体材料をキャパシタの絶縁膜に用いることにより、記憶データの不揮発性を実現しようとする半導体メモリ装置が考案されている。

【0004】 以下、強誘電体材料を用いた従来の半導体メモリ装置について説明する（米国特許第4,873,664号明細書参照）。

【0005】 図13は従来の半導体メモリ装置の回路構成図、図14は従来の半導体メモリ装置の回路構成を示す図13のセンスアンプ部90, 96を示す図、図15は従来の半導体メモリ装置の動作タイミングを示す図、図16は従来の半導体メモリ装置のメモリセルキャパシタの強誘電体のヒステリシス特性とメモリセルのデータ読み出しを示す図である。

【0006】 図において、Vr16はメモリセルのデータ読み出し電位差、11, 12はビット線の寄生容量の特性を示す線、A, B, D, E, M16, N16, O16, P16, Q16はメモリセルのデータ読み出しを示す図中の点、80a～80dはメモリセル、81a～81dはメモリセルトランジスタ、82, 84はワード線（WORD）、83a～83dは強誘電体膜を用いたメモリセルキャパシタ、86, 88, 92, 94はビット線、90, 96はセンスアンプ、98, 100はセルプレート電極（PLATE）、102, 104, 106, 108はビット線プリチャージ用トランジスタ、ΦPRECHARGEはビット線プリチャージ制御信号、ΦSENSEはセンスアンプ制御信号、110, 112はPチャネル型MOSトランジスタ、118, 120はNチャネル型MOSトランジスタ、114, 116は信号ノードである。

【0007】 図13の従来の半導体メモリ装置の回路構成は、センスアンプ90にビット線86, 88が接続されている。このビット線86, 88に本体メモリセル8

0 a, 80 bが接続されている。本体メモリセル80 aは、第1の本体メモリセルキャパシタ83 aが第1のMOSトランジスタ81 aを介してビット線86に接続されている。第2の本体メモリセルキャパシタ83 aが第2のMOSトランジスタ81 aを介してビット線88に接続されている。第1および第2のMOSトランジスタ81 aのゲートはワード線82に接続され、第1および第2の本体メモリセルキャパシタ83 aの第1および第2のMOSトランジスタ81 aのソースに接続された第1の電極とは反対の第2の電極はセルプレート電極98に接続されている。本体メモリセル80 b～80 dについても同様である。また、ビット線86, 88は、ゲートがビット線プリチャージ制御信号φPRECHARGEであるMOSトランジスタ106, 108を介して接地電圧に接続されている。また、センスアンプ90は、図14に示すように、Nチャネル型MOSトランジスタ118のソースが接地電圧に、ゲートが信号ノード116に、ドレインが信号ノード114にそれぞれ接続され、Pチャネル型MOSトランジスタ110のソースがφPRECHARGEに接続されている。また、ゲートが信号ノード116に、ドレインが信号ノード114にそれぞれ接続され、Nチャネル型MOSトランジスタ120のソースが接地電圧に、ゲートが信号ノード114に、ドレインが信号ノード116にそれぞれ接続され、Pチャネル型MOSトランジスタ112のソースはφPRECHARGEに、ゲートが信号ノード114に、ドレインが信号ノード116にそれぞれ接続されている。この図13の従来の半導体メモリ装置では、一つのメモリセルが二つのメモリセルキャパシタと二つのMOSトランジスタとで構成されている。この二つのメモリセルキャパシタには逆論理電圧を書き込み、読み出し時にはこの二つのメモリセルキャパシタのそれぞれから読み出された電位差をセンスアンプで増幅してデータを読み出す。

【0008】この従来の半導体メモリ装置の回路の動作について、図15の動作タイミング図と、図16のメモリセルキャパシタの強誘電体のヒステリシス特性とメモリセルのデータ読み出しを示す図を参照しながら説明する。

【0009】図16の強誘電体のヒステリシス特性図で、横軸がメモリセルキャパシタにかかる電界で縦軸がそのときの電荷を示している。強誘電体のキャパシタでは電界が0のときでも点B、点Eのように残留分極が残る。このように、電源がオフした後にも強誘電体のキャパシタに残った残留分極を不揮発性のデータとして利用し、不揮発性半導体メモリ装置を実現している。メモリセルのデータが“1”的場合、第1の本体メモリセルキャパシタは図16の点Bの状態であり、第2の本体メモリセルキャパシタは図16の点Eの状態である。メモリセルのデータが“0”である場合には、第1の本体メモリセルキャパシタは図16の点Dの状態であり、第2の本体メモリセルキャパシタは図16の点Aの状態である。

リセルキャパシタは図16の点Eの状態で、第2の本体メモリセルキャパシタは図16の点Bの状態である。

【0010】ここで本体メモリセルのデータを読み出すために、初期状態として、ビット線86, 88、ワード線82, 84、セルプレート電極98、および、センスアンプ制御信号φSENSEは全て論理電圧“L”であり、ビット線プリチャージ制御信号φPRECHARGEは論理電圧“H”である。その後、ビット線プリチャージ制御信号φPRECHARGEを論理電圧“L”とし、ビット線86, 88をフローティング状態とする。次に、図15のように、ワード線82とセルプレート電極98を論理電圧“H”とする。ここで、MOSトランジスタ81 aがオンする。このため、本体メモリセルキャパシタ83 aには電界がかかり、本体メモリセルからビット線86, 88にデータが読み出される。

【0011】このときのビット線に読み出される電位差について図16を参照しながら説明する。図16に示されている線11, 12はビット線86, 88の寄生容量値で決まる傾きを持つ線である。容量値が小さくなると傾きの絶対値は小さくなる。読み出されるデータが

“1”的とき、ビット線86には第1の本体メモリセルキャパシタからデータが読み出され、図16の点Bの状態から点O16の状態となる。点O16はメモリセルキャパシタに電界をかけたとき、点Bから点Dへ向かうヒステリシス曲線と、ワード線82とセルプレート電極98との論理電圧を“H”としたときに生じる電界の分だけ、点Bから横軸方向へ移動した点M16を通る線11との交点である。同様に、ビット線88には第2の本体メモリセルキャパシタからデータが読み出され、図16の点Eの状態から点P16の状態となる。点P16はメモリセルキャパシタに電界がかかったとき、点Eから点Dへ向かうヒステリシス曲線と、ワード線82とセルプレート電極98との論理電圧を“H”としたときに生じる電界の分だけ、点Eから横軸方向へ移動した点N16を通る線12との交点である。ここで、ビット線86とビット線88に読み出される電位差は、図16の点O16と点P16との電界差であるVr16となる。読み出されるデータが“0”的ときも同様で、ビット線86とビット線88の状態が逆になるだけで、読み出される電位差はVr16である。次に、センスアンプ制御信号φSENSEを論理電圧“H”とし、ビット線86とビット線88に読み出されたデータをセンスアンプ90で増幅しデータを読み出す。このセンスアンプ90で増幅すると、ビット線86の状態は点O16から点Q16になり、ビット線88の状態は点P16から点Dになる。次に、データの再書き込み状態としてセルプレート電極98を論理電圧“L”とする。このとき、図16において、ビット線86の状態は点Q16から点Aとなり、ビット線88の状態は点Dから点Eとなる。次に、ワード線82とセンスアンプ制御信号φSENSEとを論理電

圧“L”にする。その後、ピット線プリチャージ制御信号φPRECHARGEを論理電圧“H”とし、ピット線86, 88を論理電圧“L”として初期状態とする。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来の構成の半導体メモリ装置では、図16において、ピット線の寄生容量値が小さくなると線11, 12の傾きの絶対値が小さくなる。たとえばピット線の寄生容量値がほとんど0になると、点O16の位置は点Bに近づき、点P16の位置は点Eに近づく。ピット線86とピット線88とに生じる読み出し電位差V_{r16}は0に近づく。このためこの電位差をセンスアンプ90で正確に増幅することができなくなるという課題があった。また、同様にピット線寄生容量値がある一定の値であるとき強誘電体キャパシタの容量が小さすぎても大きすぎてもピット線86とピット線88とに生じる読み出し電位差V_{r16}は小さくなり、この電位差をセンスアンプ90で正確に増幅することができなくなるという課題があった。

【0013】

【課題を解決するための手段】この課題を解決するため20に、本発明の半導体メモリ装置は、増幅器に第1のピット線と第1のピット線と対になった第2のピット線が接続され、第1のMOSトランジスタに第1のワード線と第1の強誘電体キャパシタと第1のピット線とが接続され、第1の強誘電体キャパシタが第1のプレート電極に接続され、第1のピット線と第2のピット線との間に生じる電位差を所望の値にするように第1の強誘電体キャパシタの容量が決定される。

【0014】また、電位差が増幅器によって正常に増幅できる値である。また、容量が小さく設定される。

【0015】また、増幅器に第1のピット線と第1のピット線と対になった第2のピット線が接続され、第1のMOSトランジスタに第1のワード線と第1の強誘電体キャパシタと第1のピット線とが接続され、第1の強誘電体キャパシタが第1のプレート電極に接続され、第2のMOSトランジスタが第2のワード線と第1のキャパシタと第2のピット線とに接続され、第1のキャパシタが第2のプレート電極に接続され、第1の強誘電体キャパシタの論理電圧“H”で、かつ第1のピット線へのデータ読み出し時の第1のピット線電位と第1の強誘電体キャパシタの論理電圧“L”で、かつ第1のピット線へのデータ読み出し時の第2のピット線電位との電位差が第1の所望の値になるように第1の強誘電体キャパシタの容量が決定され、第1のキャパシタの第2のピット線へのデータ読み出し時の第3のピット線電位が第1のピット線電位と第2のピット線電位との中間の第2の所望の値の電位になるように第1のキャパシタの容量が決定される。

【0016】また、第1のキャパシタが強誘電体キャパシタである。また、第1のキャパシタが第1の強誘電体

キャパシタと同程度の形状である強誘電体キャパシタである。

【0017】また、第1のキャパシタの第2のピット線へのデータ読み出し時に第2のピット線の容量に第1のピット線容量調整用容量が接続され第1のピット線の容量より大きくなる。

【0018】また、第1のピット線容量調整用容量が強誘電体キャパシタである。また、第1のキャパシタの第2のピット線へのデータ読み出し時に第2のピット線の容量に第1のピット線容量調整用容量が切断され第1のピット線の容量より小さくなる。

【0019】さらに、第1のピット線容量調整用容量が強誘電体キャパシタである。

【0020】

【作用】上記のような構成および動作の半導体メモリ装置にすることにより、メモリセルのデータ読み出し電位差を大きくすることができ、読み出し時の誤動作がない半導体メモリ装置とすることができる。

【0021】

【実施例】本発明の半導体メモリ装置の第1の実施例について、図面を参照しながら説明する。図1は本発明の半導体メモリ装置の回路構成を示す図、図2は本発明の半導体メモリ装置の動作タイミングを示す図、図3～図5は本発明の半導体メモリ装置の第1の実施例の第1～第3の容量値のメモリセルキャパシタの強誘電体のヒステリシス特性とメモリセルのデータ読み出しを示す図である。

【0022】まず、図1の回路構成図について説明する。WL0～WL7はワード線、BL0, /BL0, BL1, /BL1はピット線、CP0～CP7はセルプレート電極、EQ101はピット線イコライズおよびプリチャージ制御信号、SAE100はセンスアンプ制御信号、VSSは接地電圧、SA0, SA1はセンスアンプ、Cs00～Cs17, Cs00B～Cs17Bは本体メモリセルキャパシタ、QnはNチャネル型MOSトランジスタである。

【0023】センスアンプSA0にピット線BL0, /BL0が、センスアンプSA1にピット線BL1, /BL1がそれぞれ接続されている。センスアンプSA0, SA1の動作はセンスアンプ制御信号SAE100によって制御される。本体メモリセルキャパシタCs00の第1の電極はNチャネル型MOSトランジスタQnを介してピット線BL0に接続されている。本体メモリセルキャパシタCs00の第2の電極はセルプレート電極CP0に接続されている。本体メモリセルキャパシタCs00Bの第1の電極はNチャネル型MOSトランジスタQnを介してピット線/BL0に接続されており、本体メモリセルキャパシタCs00Bの第2の電極はセルプレート電極CP0に接続されている。同様に、本体メモリセルキャパシタCs01～Cs07のそれぞれの第1

の電極はNチャネル型MOSトランジスタQnを介してビット線BL0に接続され、本体メモリセルキャパシタCs01～Cs07のそれぞれの第2の電極はそれぞれセルプレート電極CP1～CP7に接続され、本体メモリセルキャパシタCs01B～Cs07Bのそれぞれの第1の電極はNチャネル型MOSトランジスタQnを介してビット線/BL0に接続され、本体メモリセルキャパシタCs01B～Cs07Bのそれぞれの第2の電極はそれぞれセルプレート電極CP1～CP7に接続されている。本体メモリセルキャパシタCs10～Cs17, Cs10B～Cs17Bについても同様に、ビット線BL1, /BL1にデータが読み出されるように接続されている。また、ビット線BL0, /BL0, およびビット線BL1, /BL1はビット線イコライズおよびプリチャージ制御信号EQ101によってイコライズおよびプリチャージされるように構成されている。ここでは、プリチャージ電位は接地電圧としている。

【0024】図3においてVr3はメモリセルのデータ読み出し電位差、I1, I2はビット線容量の特性を示す線、A, B, D, E, M3, N3, O3, P3, Q3はメモリセルのデータ読み出しを示す図における点である。図3は従来と同様に強誘電体のヒステリシス特性図で、横軸がメモリセルキャパシタにかかる電界で縦軸がそのときの電荷を示している。強誘電体のキャパシタでは電界が0のときでも点B、点Eのように残留分極が残る。電源をオフしても強誘電体のキャパシタに残った残留分極を不揮発性のデータとして利用して、不揮発性半導体メモリ装置を実現している。メモリセルのデータが“1”的場合、第1の本体メモリセルキャパシタは図3の点Bの状態で、第2の本体メモリセルキャパシタは点Eの状態である。メモリセルのデータが“0”的場合、第1の本体メモリセルキャパシタは点Eの状態で、第2の本体メモリセルキャパシタは点Bの状態である。

【0025】図4および図5も図3と同様で、Vr4～Vr5はメモリセルのデータ読み出し電位差、A, B, D, E, M4, N4, O4, P4, Q4, M5, N5, O5, P5, Q5はメモリセルのデータ読み出しを示す図における点である。本体メモリセルキャパシタの容量は図3の場合が三つのうちではもっとも大きく、図4の場合が次に大きく、図5の場合が三つのうちではもっとも小さい。

【0026】ここでは、図3の場合について、本体メモリセルキャパシタCs00, Cs00Bのデータを読み出す方法について説明する。まず本体メモリセルのデータを読み出すために、初期状態として、ビット線BL0, /BL0, ワード線WL0～WL7, セルプレート電極CP0～CP7、および、センスアンプ制御信号SAE100を論理電圧“L”とし、ビット線プリチャージ制御信号EQ101は論理電圧“H”とする。その後、ビット線プリチャージ制御信号EQ101を論理電圧“H”とし、ビット線BL0, /BL0を論理電圧“L”として、初期状態にする。この動作でビット線BL0, /BL0に読み出された電位差Vr3はセンスアンプSA0で正確に増幅できるだけの電位差でなければならない。これを満たすように本体メモリセルキャパシタ容量値（曲線ABDEA）を決定する。電位差Vr3ができるだけ大きくなるように本体メモリセルキャパシタ容量値を決定することにより、センスアンプによるより正確で高速な増幅が可能と

圧“L”とすると、ビット線BL0, /BL0をフローティング状態となる。次に、ワード線WL0とセルプレート電極CP0を論理電圧“H”とする。このとき、本体メモリセルキャパシタCs00, Cs00Bに電界がかかる。このようにして本体メモリセルからBL0, /BL0ビット線にデータが読み出される。このときのビット線に読み出される電位差について、図3を参照しながら説明する。線I1, I2はビット線BL0, /BL0の寄生容量の値に依存した傾きを持つ。容量値が小さくなると傾きの絶対値は小さくなる。読み出されるデータが“1”的とき、ビット線BL0には本体メモリセルキャパシタCs00からデータが読み出され、図3の点Bの状態から点O3の状態となる。点O3はメモリセルキャパシタに電界がかかるとき、点Bから点Dへ向かう強誘電体メモリセルキャパシタのヒステリシス曲線と、ワード線WL0とセルプレート電極CP0とを論理電圧“H”としたときに生じる電界の分だけ点Bから横軸方向へ移動した点M3を通る線I1との交点である。同様に、ビット線/BL0には本体メモリセルキャパシタCs00Bからデータが読み出され、点Eの状態から点P3の状態となる。点P3はメモリセルキャパシタに電界がかかるとき、点Eから点Dへ向かうヒステリシス曲線と、ワード線WL0とセルプレート電極CP0とを論理電圧“H”としたときに生じる電界の分だけ点Eから横軸方向へ移動した点N3を通る線I2との交点である。ここで、ビット線BL0, /BL0間に読み出される電位差は点O3と点P3の電界差であるVr3となる。読み出されるデータが“0”的ときも同様に、ビット線BL0と同/BL0の状態が逆になるだけで、読み出される電位差はVr3である。次に、センスアンプ制御信号SAE100を論理電圧“H”とすると、ビット線BL0, /BL0に読み出されたデータはセンスアンプSA0で増幅されて読み出される。センスアンプSA0で増幅したとき、ビット線BL0の状態は点O3から点Q3になり、ビット線/BL0の状態は点P3から点Dになる。次に、データの再書き込み状態としてセルプレート電極CP0を論理電圧“L”とする。このとき、ビット線BL0の状態は点Q3から点Aとし、ビット線/BL0の状態は点Dから点Eとなる。その後、ワード線WL0とセンスアンプ制御信号SAE100とを論理電圧“L”とする。その後、ビット線プリチャージ制御信号EQ101を論理電圧“H”とし、ビット線BL0, /BL0を論理電圧“L”として、初期状態にする。この動作でビット線BL0, /BL0に読み出された電位差Vr3はセンスアンプSA0で正確に増幅できるだけの電位差でなければならない。これを満たすように本体メモリセルキャパシタ容量値（曲線ABDEA）を決定する。電位差Vr3ができるだけ大きくなるように本体メモリセルキャパシタ容量値を決定することにより、センスアンプによるより正確で高速な増幅が可能と

なる。

【0027】図3～図5の本体メモリセルキャパシタ容量値の場合、 $V_{r3} \sim V_{r5}$ のメモリセルのデータ読み出し電位差は V_{r4} が大きく、 V_{r3} と V_{r5} は V_{r4} より小さくなる。本体メモリセルキャパシタ容量値 C_s とビット線 $BL_0, /BL_0$ 間に読み出された電位差 V_r との関係を示したものが図6である。この図6からわかるように、電位差 V_r は本体メモリセルキャパシタ容量値 C_s に対して最大値をもつ曲線で表される。図6で V_{rm} はセンスアンプで正確に増幅できる読み出し可能最低電位差値を示している。この V_{rm} と図の曲線の交点のうち本体メモリセルキャパシタ容量値の小さい方を C_{s1} 、本体メモリセルキャパシタ容量値の大きい方を C_{sh} とする。この図より本体メモリセルキャパシタ容量の値 C_s は C_{s1} と C_{sh} との間にあることが必要である。本体メモリセルキャパシタ容量の値 C_s が C_{s1}, C_{sh} 間であれば、より小さな値を用いる方が本体メモリセルキャパシタを構成する強誘電体膜の劣化が少ない。また、本体メモリセルキャパシタの面積も小さくなり、高集積化される。

【0028】本発明の半導体メモリ装置の第2の実施例について、図7の回路構成図と図8の動作タイミング図、図9のメモリセルキャパシタの強誘電体のヒステリシス特性とメモリセルのデータ読み出しを示す図を参照しながら説明する。

【0029】第1の実施例が一つのメモリセルが二つのメモリセルキャパシタと二つのMOSトランジスタで構成されているのに対して、第2の実施例が一つのメモリセルが一つのメモリセルキャパシタと一つのMOSトランジスタで構成されている点で異なる。

【0030】まず、図7に示した回路構成について説明する。WL0～WL3はワード線、DWL0～DWL1はダミーワード線、 $BL_0, /BL_0, BL_1, /BL_1$ はビット線、 CP_0, CP_1 はセルプレート電極、 DCP_0, DCP_1 はダミーセルプレート電極、 EQ_{11} はビット線イコライズおよびプリチャージ制御信号、 SAE_0, SAE_1 はセンスアンプ制御信号、 VSS は接地電圧、 SA_0, SA_1 はセンスアンプ、 $C_{s1} \sim C_{s8}$ は本体メモリセル強誘電体キャパシタ、 $Cd_1 \sim Cd_4$ はダミーメモリセル強誘電体キャパシタ、 Q_n はNチャネル型MOSトランジスタである。本体メモリセルは本体メモリセル強誘電体キャパシタ $C_{s1} \sim C_{s8}$ とワード線WL0～WL3がゲートに接続されたNチャネル型MOSトランジスタ Q_n で構成されている。本体メモリセル強誘電体キャパシタ $C_{s1} \sim C_{s8}$ の第1の電極がNチャネル型MOSトランジスタ Q_n のソースに接続され、本体メモリセル強誘電体キャパシタ $C_{s1} \sim C_{s8}$ の第2の電極がセルプレート電極 CP_0, CP_1 に接続されている。また、本体メモリセルを構成するNチャネル型MOSトランジスタ Q_n のドレインはビット線 B

$L_0, /BL_0, BL_1, /BL_1$ に接続されている。ダミーメモリセルも同様に、ダミーメモリセル強誘電体キャパシタ $Cd_1 \sim Cd_4$ とダミーワード線 $DWL_0 \sim DWL_1$ がゲートに接続されたNチャネル型MOSトランジスタ Q_n とで構成されている。また、ダミーメモリセル強誘電体キャパシタ $Cd_1 \sim Cd_4$ の第1の電極がNチャネル型MOSトランジスタ Q_n のソースに接続され、ダミーメモリセル強誘電体キャパシタ $Cd_1 \sim Cd_4$ の第2の電極がダミーセルプレート電極 DCP_0, DCP_1 に接続されている。また、ダミーメモリセルを構成するNチャネル型MOSトランジスタ Q_n のドレインは、ビット線 $BL_0, /BL_0, BL_1, /BL_1$ に接続されている。また、ビット線 $BL_0, /BL_0$ および同 $BL_1, /BL_1$ は、それぞれセンスアンプ SA_0, SA_1 に接続されている。センスアンプ SA_0, SA_1 は、それぞれセンスアンプ制御信号 SAE_0, SAE_1 で制御され、センスアンプ制御信号 SAE_0, SAE_1 が全て論理電圧“H”のとき動作する。また、ビット線 $BL_0, /BL_0$ および同 $BL_1, /BL_1$ は、ゲートがビット線イコライズおよびプリチャージ制御信号 EQ_{11} であるNチャネル型MOSトランジスタ Q_n を介して接地電圧 VSS に接続されている。

【0031】次に、図8と図9において、本体メモリセルのデータを読み出すために、初期状態として、ワード線 $WL_0 \sim WL_3$ 、ダミーワード線 DWL_0, DWL_1 、セルプレート電極 CP_0, CP_1 、ダミーセルプレート電極 DCP_0, DCP_1 、センスアンプ制御信号 SAE_0, SAE_1 を論理電圧“L”とし、ビット線イコライズおよびプリチャージ制御信号 EQ_{11} を論理電圧“H”とし、ビット線を論理電圧“L”とする。その後、ビット線イコライズおよびプリチャージ制御信号 EQ_{11} を論理電圧“L”とし、ビット線をフローティング状態とする。次に、本体メモリセルキャパシタ C_{s2} のデータを読み出すために、ワード線 WL_1 、ダミーワード線 DWL_1 、セルプレート電極 CP_0 、およびダミーセルプレート電極 DCP_0 の全てを論理電圧“H”とすると、ビット線 BL_0 にダミーメモリセルのデータが読み出され、ビット線 $/BL_0$ に本体メモリセルのデータが読み出される。このとき、本体メモリセルのデータが“1”的場合、図9の点Bの状態から点O9の状態になる。本体メモリセルのデータが“0”的場合、点Eの状態から点P9の状態になり、ダミーメモリセルは点T9の状態から点S9の状態になる。その後、センスアンプ制御信号 SAE_0 を論理電圧“H”として、センスアンプ SA_0 を動作させると、ビット線 $BL_0, /BL_0$ に読み出されたデータが増幅される。センスアンプを動

作させ、データが増幅された状態で、本体メモリセルのデータが“1”であれば、本体メモリセルは点O 9の状態から点Q 9の状態に、ダミーメモリセルは点S 9の状態から点Dの状態になる。このとき、本体メモリセルのデータが“0”であれば、本体メモリセルは点P 9の状態から点Dの状態に、ダミーメモリセルは点S 9の状態から点T 9の状態になる。

【0032】次に、セルプレート電極CP 0を論理電圧“L”とする。このとき、本体メモリセルのデータが“1”であれば、本体メモリセルは点Q 9の状態から点Aの状態に、ダミーメモリセルは点Dの状態を維持する。本体メモリセルのデータが“0”であれば、本体メモリセルは点Dの状態から点Eの状態に、ダミーメモリセルは点T 9の状態を維持する。ワード線WL 1、ダミーワード線DWL 1を論理電圧“L”とする。このとき、本体メモリセルのデータが“1”であれば、本体メモリセルは点Aの状態から点Aと点Bの間の状態に、ダミーメモリセルは点Dの状態から点Dと点T 9の間の状態となる。その後ダミーメモリセルは点T 9の状態とする。本体メモリセルのデータが“0”であれば、本体メモリセルは点Eの状態を維持し、ダミーメモリセルは点T 9を維持する。次に、ダミーセルプレート電極DCP 0を論理電圧“L”とし、センスアンプ制御信号SAE 0を論理電圧“L”とし、ピット線イコライズおよびプリチャージ制御信号EQ 1 1を論理電圧“H”とし、ピット線を論理電圧“L”とする。

【0033】この第2の実施例において、ピット線の寄生容量値を傾きとしてもつ線1 1, 1 2, 1 3において、本体メモリセルのデータ“1”とデータ“0”的読み出し電位差VR 9がセンスアンプで正確に増幅できる電位差の少なくとも2倍以上となるように、本体メモリセルキャパシタ容量値を決める。次に、ダミーメモリセルの容量値を決定するために、ダミーメモリセルの容量を示す線すなわち点D, S 9, T 9を通る線と、ワード線WL 0とセルプレート電極CP 0との論理電圧を“H”とした直後に生じる電界の分だけ点T 1 7から横軸方向へ移動した点R 1 7を通る線1 3（線1 1, 1 2を平行移動した線）との交点を点S 9とする。このとき、点S 9と点P 9との電位差をV1 9、点S 9と点O 9との電位差をVh 9とし、V1 9およびVh 9がセンスアンプで正確に増幅できるだけの電位差であるようにする。理想的にはV1 9 = Vh 9 = VR 9 / 2とする。このようにして、本体メモリセルキャパシタ容量およびダミーメモリセルキャパシタ容量を決定することにより、センスアンプによって正確で高速な増幅が可能となる。ここでは、ダミーメモリセルキャパシタに強誘電体膜を用いているが、通常のキャパシタでもよい。

【0034】本発明の半導体メモリ装置の第3の実施例について、図10の回路構成図と図11の動作タイミング図を参照しながら説明する。

【0035】まず、図10の回路構成図について説明する。この回路は、第3の実施例の回路に対して、ピット線にスイッチング機能を有するMOSトランジスタを介して容量を接続した構成である。WL 0～WL 3はワード線、DWL 0～DWL 1はダミーワード線、BL 0, /BL 0, BL 1, /BL 1はピット線、CP 0, CP 1はセルプレート電極、DCP 0, DCP 1はダミーセルプレート電極、EQ 1 1はピット線イコライズおよびプリチャージ制御信号、S1 0 0, S1 0 1は制御信号、V1 0は信号、SAE 0, SAE 1はセンスアンプ制御信号、VSSは接地電圧、SA 0, SA 1はセンスアンプ、Cs 1～Cs 8は本体メモリセル強誘電体キャパシタ、Cd 1～Cd 4はダミーメモリセル強誘電体キャパシタ、Cb 1～Cb 4はピット線容量調整用容量、QnはNチャネル型MOSトランジスタである。本体メモリセルは本体メモリセル強誘電体キャパシタCs 1～Cs 8とワード線WL 0～WL 3がゲートに接続されたNチャネル型MOSトランジスタQnで構成されている。本体メモリセル強誘電体キャパシタCs 1～Cs 8の第1の電極がNチャネル型MOSトランジスタQnのソースに接続され、本体メモリセル強誘電体キャパシタCs 1～Cs 8の第2の電極がセルプレート電極CP 0, CP 1に接続されている。また、本体メモリセルを構成するNチャネル型MOSトランジスタQnのドレインはピット線BL 0, /BL 0, BL 1, /BL 1に接続されている。ダミーメモリセルも同様に、ダミーメモリセル強誘電体キャパシタCd 1～Cd 4とダミーワード線DWL 0～DWL 1がゲートに接続されたNチャネル型MOSトランジスタQnとで構成されている。また、ダミーメモリセル強誘電体キャパシタCd 1～Cd 4の第1の電極がNチャネル型MOSトランジスタQnのソースに接続され、ダミーメモリセル強誘電体キャパシタCd 1～Cd 4の第2の電極がダミーセルプレート電極DCP 0, DCP 1に接続されている。また、ダミーメモリセルを構成するNチャネル型MOSトランジスタQnのドレインは、ピット線BL 0, /BL 0, BL 1, /BL 1に接続されている。また、ピット線BL 0, /BL 0, および同BL 1, /BL 1はそれぞれセンスアンプSA 0, SA 1に接続されている。センスアンプSA 0, SA 1は、それぞれセンスアンプ制御信号SAE 0, SAE 1で制御され、センスアンプ制御信号SAE 0, SAE 1が全て論理電圧“H”的とき動作する。また、ピット線BL 0, /BL 0, および同BL 1, /BL 1は、ゲートがピット線イコライズおよびプリチャージ制御信号EQ 1 1であるNチャネル型MOSトランジスタQnを介して接続される。ピット線BL 0, /BL 0, BL 1, /BL 1のそれぞれはゲートがピット線イコライズおよびプリチャージ制御信号EQ 1 1であるNチャネル型MOSトランジスタQnを介して接地電圧VSSに接続されている。ピット線BL 0, /

BL0, BL1, /BL1にはゲートがそれぞれ信号S101, S100, S101, S100であるNチャネル型MOSトランジスタQnを介して容量Cb1, Cb2, Cb3, Cb4が接続され、それぞれの容量Cb1, Cb2, Cb3, Cb4のプレート電極が信号V10に接続されている。信号V10の電位は容量Cb1～Cb4が通常のキャパシタか、強誘電体膜を用いたキャパシタか、また強誘電体キャパシタの場合にはその使い方(ヒステリシス曲線のどの曲線部分を使うか)によって適当な電位を設定する。

【0036】次に、本体メモリセルのデータを読み出すために、初期状態として、ワード線WL0～WL3、ダミーワード線DWL0, DWL1、セルプレート電極CP0, CP1、ダミーセルプレート電極DCP0, DCPI、センスアンプ制御信号SAE0, SAE1、制御信号S100, S101を論理電圧“L”とし、ビット線イコライズおよびプリチャージ制御信号EQ11を論理電圧“H”とし、ビット線を論理電圧“L”とする。その後、ビット線イコライズおよびプリチャージ制御信号EQ11を論理電圧“L”とし、ビット線をフローティング状態とする。次に、本体メモリセルキャパシタCs2のデータを読み出すために、ワード線WL1、ダミーワード線DWL1、セルプレート電極CP0、ダミーセルプレート電極DCP0、制御信号S101の全てを論理電圧“H”とすると、ビット線BL0にダミーメモリセルのデータが読み出され、ビット線/BL0に本体メモリセルのデータが読み出される。ここで、ダミーメモリセルのデータが読み出されたビット線にビット線容量調整用容量をつけ加え容量を大きくしているのは、ダミーメモリセルを本体メモリセルキャパシタと同程度のものを使用し、メモリセルのデータ“1”から読み出したときに、適正なリファレンス電圧を得るためにある。このビット線容量調整用容量は強誘電体膜を用いても通常のキャパシタでもよい。

【0037】本発明の半導体メモリ装置の第4の実施例について、図10の回路構成図と図12の動作タイミング図を参照しながら説明する。

【0038】まず、図10の回路構成図については第3の実施例と同様である。次に、本体メモリセルのデータを読み出すために、初期状態として、ワード線WL0～WL3、ダミーワード線DWL0, DWL1、セルプレート電極CP0, CP1、ダミーセルプレート電極DCP0, DCPI、センスアンプ制御信号SAE0, SAE1を論理電圧“L”とし、ビット線イコライズおよびプリチャージ制御信号EQ11、制御信号S100, S101を論理電圧“H”とし、ビット線を論理電圧“L”とする。その後、ビット線イコライズおよびプリチャージ制御信号EQ11を論理電圧“L”とし、ビット線をフローティング状態とする。次に、本体メモリセルキャパシタCs2のデータを読み出すために、ワード

線WL1、ダミーワード線DWL1、セルプレート電極CP0、ダミーセルプレート電極DCP0の全てを論理電圧“H”、制御信号S101を論理電圧“L”とすると、ビット線BL0にダミーメモリセルのデータが読み出され、ビット線/BL0に本体メモリセルのデータが読み出される。ここで、ダミーメモリセルのデータが読み出されたビット線のビット線容量調整用容量を電気的に切断し容量を小さくしているのは、ダミーメモリセルを本体メモリセルキャパシタと同程度のものを使用し、メモリセルのデータ“0”から読み出したときに適正なリファレンス電圧を得るためにある。このビット線容量調整用容量は強誘電体膜を用いても通常のキャパシタでもよい。

【0039】

【発明の効果】本発明のメモリセルキャパシタに強誘電体膜を用いた半導体メモリ装置によれば、ビット線の寄生容量値に応じて最適なメモリセル強誘電体キャパシタの容量値を設定することにより、メモリセルのデータ読み出し電位差を大きくすることができ、読み出し時の誤動作がない半導体メモリ装置とすることができます。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体メモリ装置の第1の実施例の回路構成を示す図

【図2】本発明の半導体メモリ装置の第1の実施例の動作タイミングを示す図

【図3】本発明の半導体メモリ装置の第1の実施例の第1の容量値のメモリセルキャパシタの強誘電体のヒステリシス特性とメモリセルのデータ読み出しを示す図

【図4】本発明の半導体メモリ装置の第1の実施例の第2の容量値のメモリセルキャパシタの強誘電体のヒステリシス特性とメモリセルのデータ読み出しを示す図

【図5】本発明の半導体メモリ装置の第1の実施例の第3の容量値のメモリセルキャパシタの強誘電体のヒステリシス特性とメモリセルのデータ読み出しを示す図

【図6】本発明の半導体メモリ装置の第1の実施例のメモリセルキャパシタの容量値とデータ読み出し電位差との関係図

【図7】本発明の半導体メモリ装置の第2の実施例の回路構成を示す図

【図8】本発明の半導体メモリ装置の第2の実施例の動作タイミングを示す図

【図9】本発明の半導体メモリ装置の第2の実施例のメモリセルキャパシタの強誘電体のヒステリシス特性とメモリセルのデータ読み出しを示す図

【図10】本発明の半導体メモリ装置の第3および第4の実施例の回路構成を示す図

【図11】本発明の半導体メモリ装置の第3の実施例の動作タイミングを示す図

【図12】本発明の半導体メモリ装置の第4の実施例の動作タイミングを示す図

15

【図13】従来の半導体メモリ装置の回路構成を示す図
【図14】従来の半導体メモリ装置の回路構成のセンスアンプ部を示す図

【図15】従来の半導体メモリ装置の動作タイミングを示す図

【図16】従来の半導体メモリ装置のメモリセルキャバシタの強誘電体のヒステリシス特性とメモリセルのデータ読み出しを示す図

【符号の説明】

11~13 線
80a~80d メモリセル
81a~81d メモリセルトランジスタ
82 ワード線 (WORD)
83a~83d メモリセルキャバシタ
84 ワード線 (WORD)
86, 88 ピット線
90 センスアンプ
92, 94 ピット線
96 センスアンプ
98, 100 セルプレート電極 (PLATE)
102, 104, 106, 108 ピット線プリチャージ用トランジスタ
110, 112 Pチャネル型MOSトランジスタ

* 114, 116 信号ノード

118, 120 Nチャネル型MOSトランジスタ

BL0, /BL0, BL1, /BL1 ピット線

Cb1~Cb4 ピット線容量調整用容量

S100, S101, V10 制御信号

Csh, Cs1 本体メモリセル容量値

Cd1~Cd4 ダミーメモリセルキャバシタ

CP0~CP7 セルプレート電極

Cs00~Cs17, Cs00B~Cs17B, Cs10~Cs8 本体メモリセルキャバシタ

DCP0, DCP1 ダミーセルプレート電極

DWL0~DWL1 ダミーワード線

EQ11~EQ101 ピット線イコライズおよびプリチャージ制御信号

Qn Nチャネル型MOSトランジスタ

SA0, SA1 センスアンプ

SAE100, SAE101 センスアンプ制御信号

V19, Vh9, Vr3~Vr5, Vr16 電位差

Vrm 読み出し可能最低電位差値

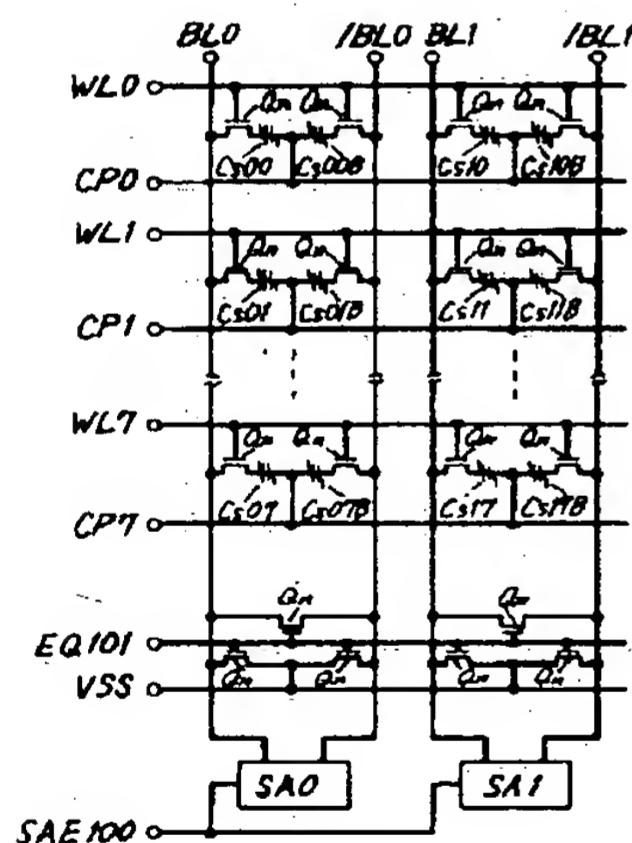
VSS 接地電圧

WL0~WL7 ワード線

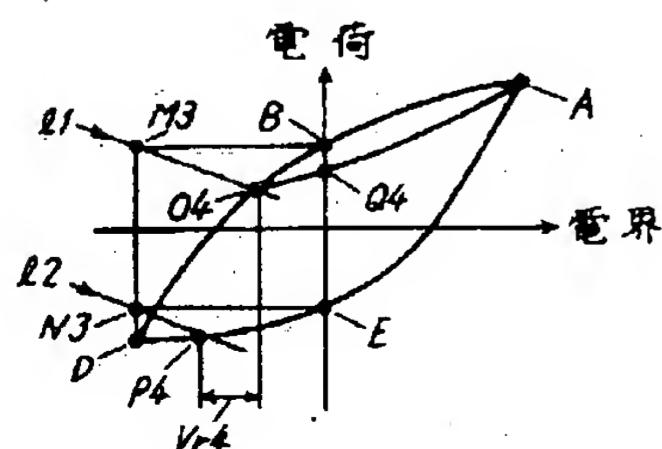
φPRECHARGE ピット線プリチャージ制御信号

φSENSE センスアンプ制御信号

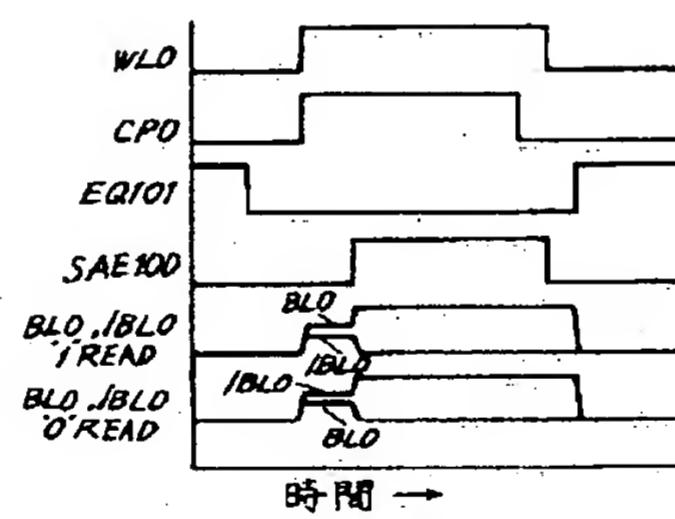
【図1】



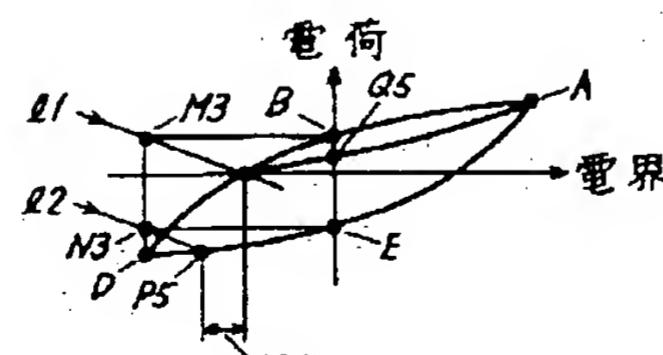
【図4】



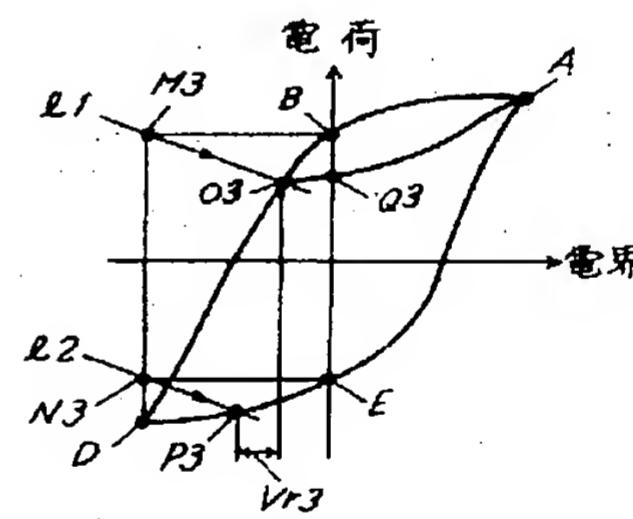
【図2】



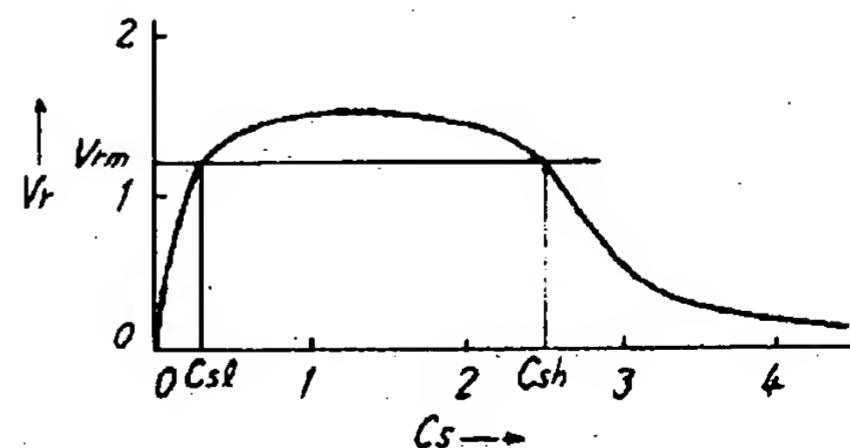
【図5】



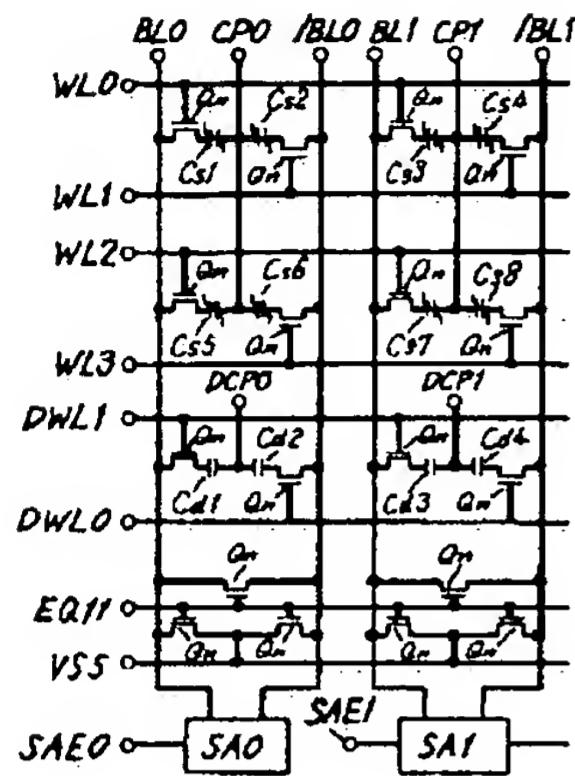
【図3】



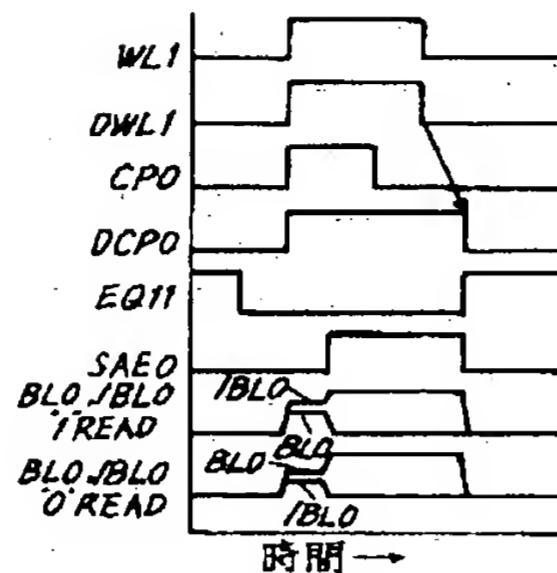
【図6】



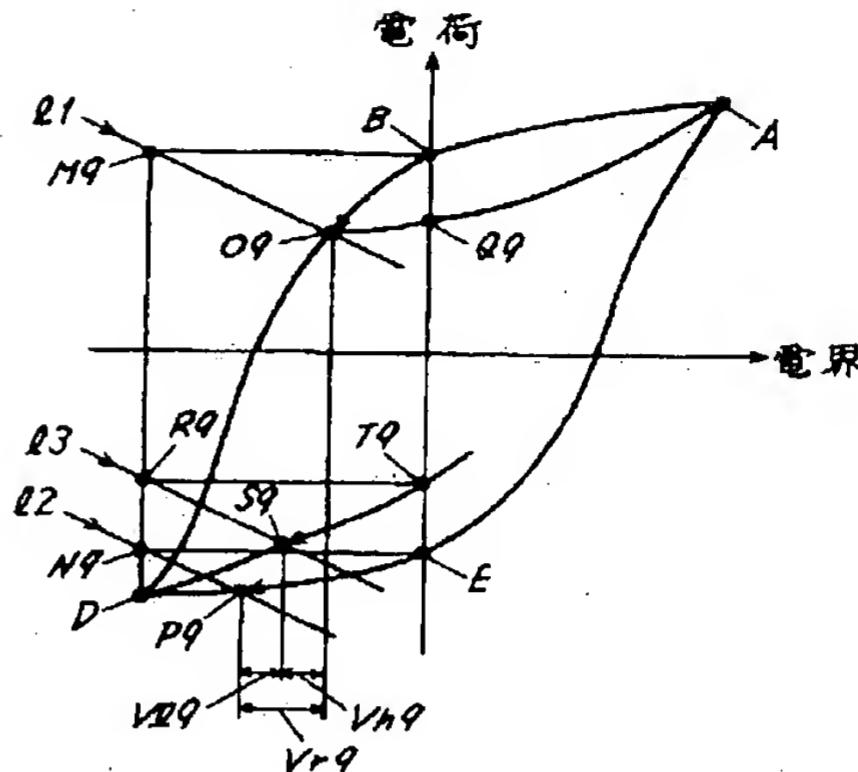
【図7】



【図8】

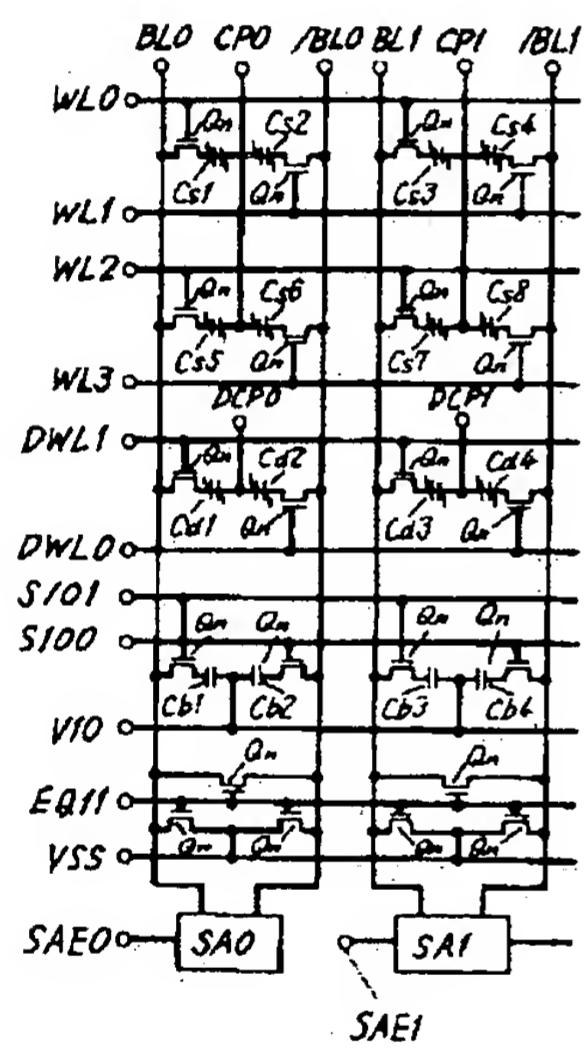


【図9】

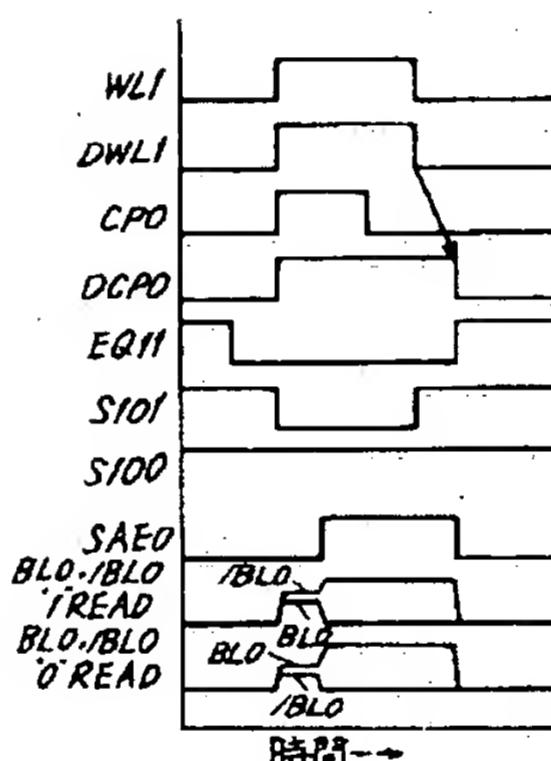


【図11】

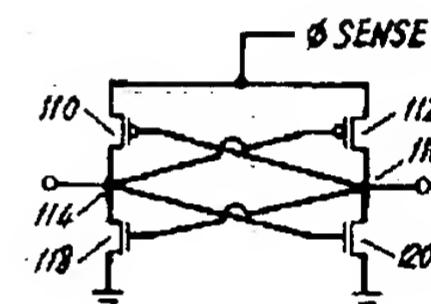
【図10】



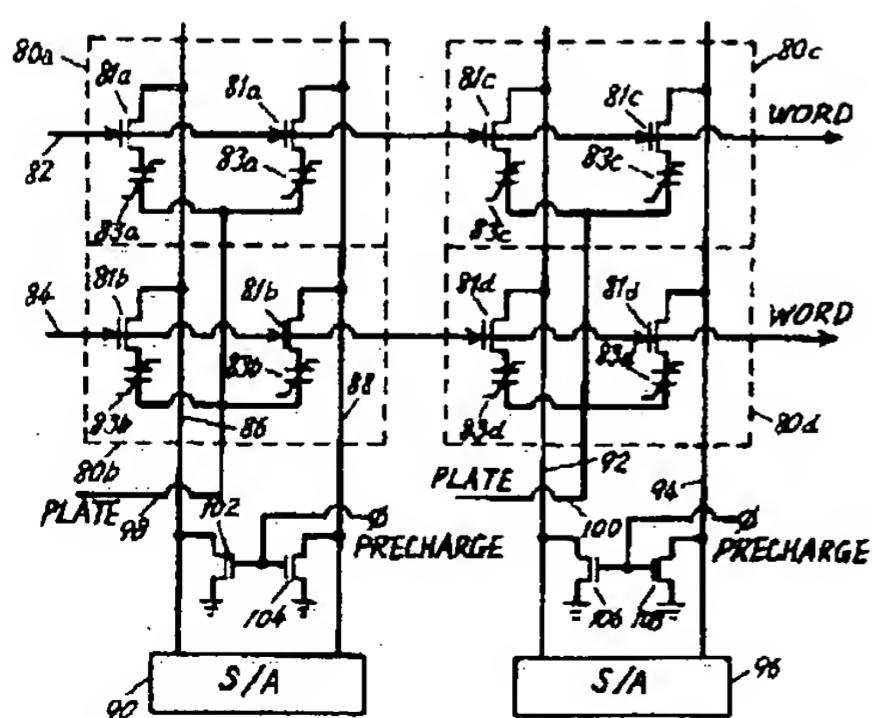
【図12】



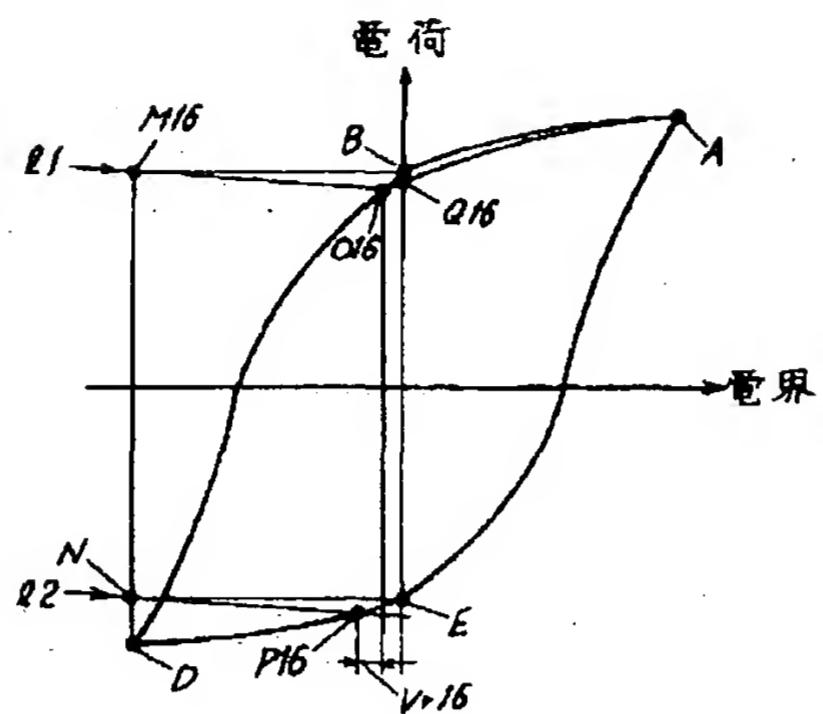
【図14】



【図13】



【図1-6】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

H 01 L 27/108
21/8242

識別記号 庁内整理番号

F I

技術表示箇所